



主要特点

工作频率: DC - 20 GHz

插入损耗: 0.2 dB

衰减范围: 0dB、0.25dB、0.5dB、1dB、1.5dB、
2dB、2.5dB、3dB、3.5dB、3.75dB

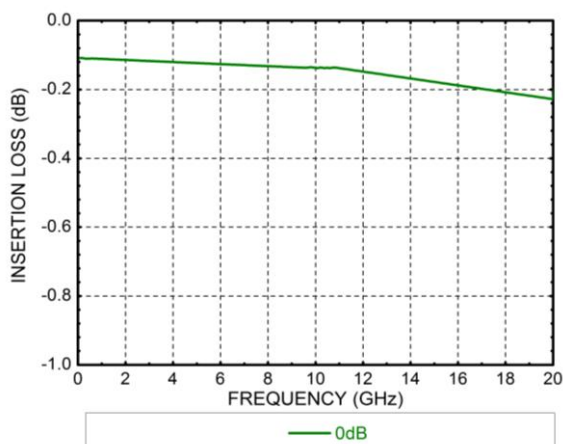
输入/输出回波损耗: 20 dB

芯片尺寸: $1.0 \times 0.6 \times 0.1 \text{ mm}^3$

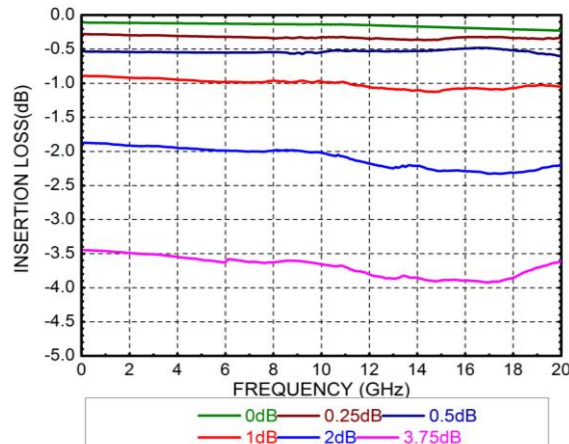
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 20			GHz
插入损耗		0.2		dB
衰减精度		± 0.2		dB
输入回波损耗		20		dB
输出回波损耗		20		dB

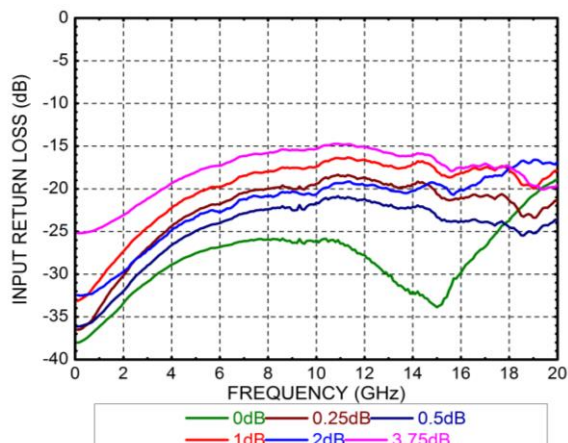
参考态插入损耗



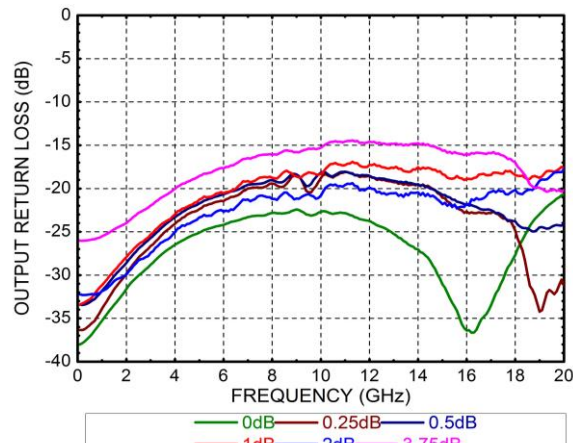
插入损耗



输入回波损耗

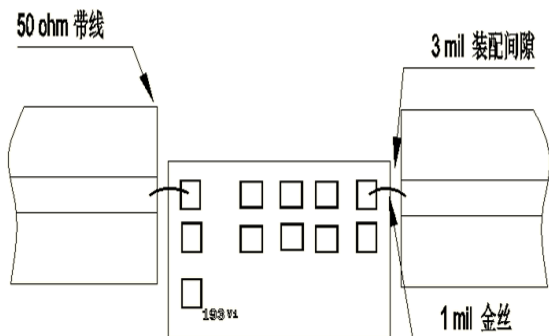


输出回波损耗

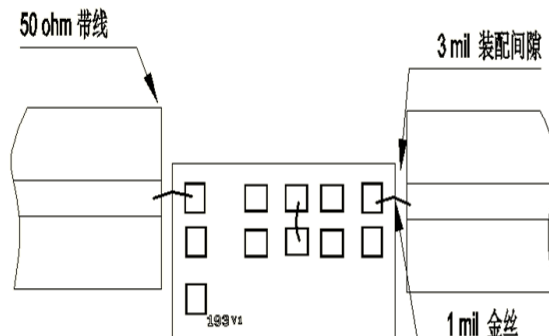


装配示意图

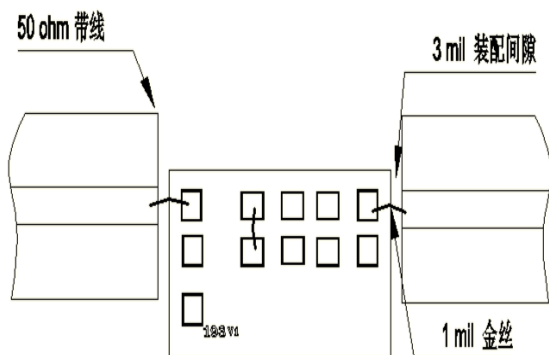
参考态键合



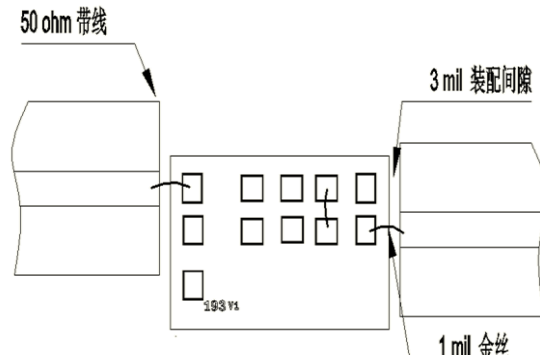
衰减0.25dB键合



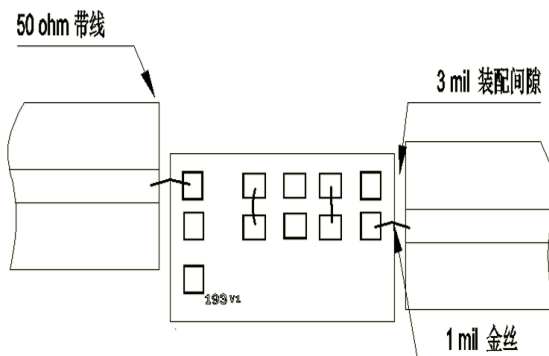
衰减0.5dB键合



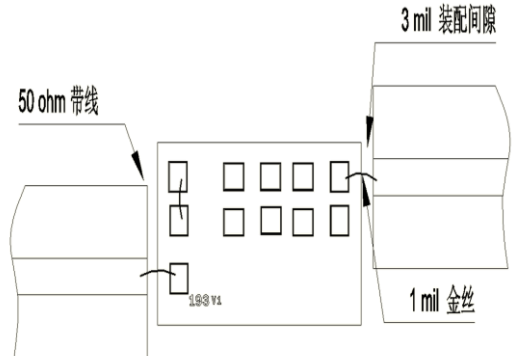
衰减1dB键合



衰减1.5dB键合



衰减2dB键合





中科海高
HiGaAs Microwave

V1.2

HGC193

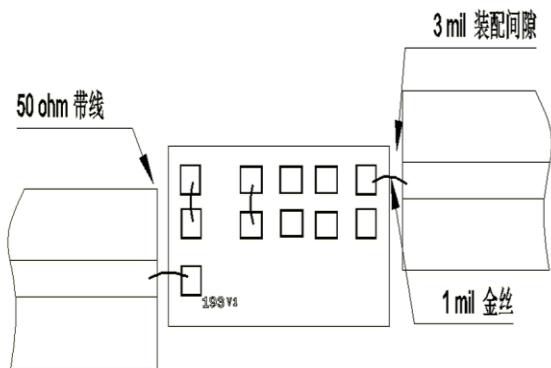
GaAs MMIC

可调衰减器, DC - 20 GHz

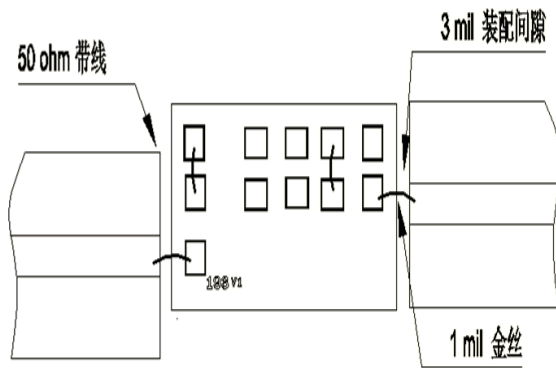
6

可调衰减器
裸芯片

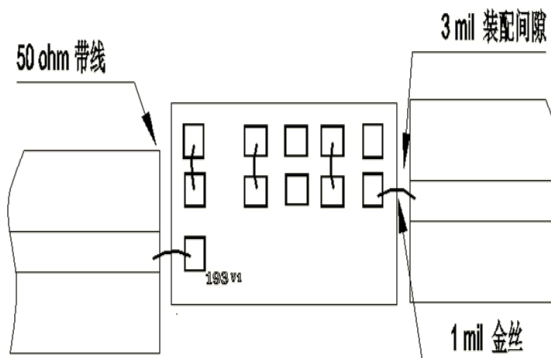
衰减2.5dB键合



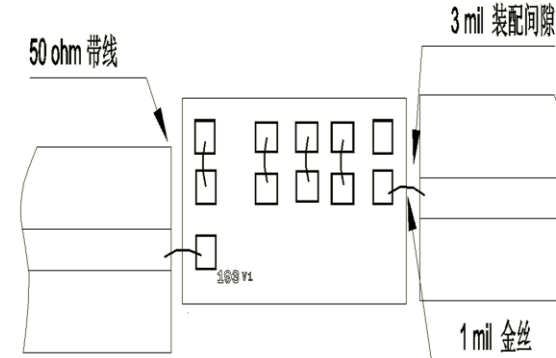
衰减3dB键合



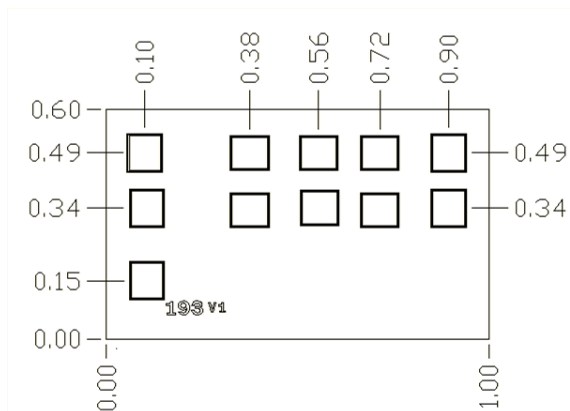
衰减3.5dB键合



衰减3.75dB键合



物理参数



极限参数

最大输入功率	+27 dBm
存储温度	-65 ~ +150° C
工作温度	-55 ~ +85° C